

2026年3月期 第3四半期 決算説明資料

2026年2月10日

JX JX金属株式会社

1

ハイライト

2

2025年度（2026年3月期） 第3四半期実績

3

2025年度（2026年3月期） 通期見通し

4

Appendix

ハイライト

ハイライト – 2025年度第3四半期累計実績・2025年度通期見通し

第3四半期累計実績

通期見通し

営業利益 (一過性要因含み)

前年同期

862 億円

一過性要因

54億円*1

営業利益 (一過性要因除き)

808 億円

為替 153 円/USD
銅価 425 ¢/lb

実績

1,248 億円

25億円*2

1,223 億円

為替 149 円/USD
銅価 460 ¢/lb

差異

+386 億円

+415 億円

為替 4 円/USD 円高
銅価 +35 ¢/lb

フォーカス事業主力製品の増販に加え
銅価上昇等も寄与し、
415億円の増益
(一過性要因除き対比)

営業利益

11月公表

1,250 億円

為替 146 円/USD
銅価 436 ¢/lb

2月公表

1,500 億円

為替 149 円/USD
銅価 470 ¢/lb

差異

+250 億円

為替 3 円/USD 円安
銅価 +34 ¢/lb

フォーカス事業の好調な販売状況に加え、
為替および銅価前提の見直しを行い
250億円の上方修正

配当予想

11月公表時

21 円/株

2月公表*3

27 円/株

変更額

+6 円/株

営業利益 上方修正に伴い**増配予定**

*1: (内訳) カセロネス一部権益売却益: 74億円、タツタ電線 負ののれん等: 48億円、機能材料事業海外子会社減損: ▲12億円、Taniobisのれん減損・構造改革費用: ▲56億円

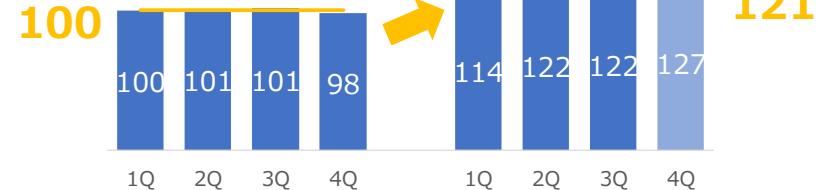
*2: (内訳) ケチュア銅プロジェクト権益売却益: 25億円 *3: 配当計算の前提銅価 4~12月: 460 ¢/lb 1月~3月: 500 ¢/lb

ハイライト

■ 主な製品 販売数量 (2024年度実績 = 100として指指数化)

前年度対比

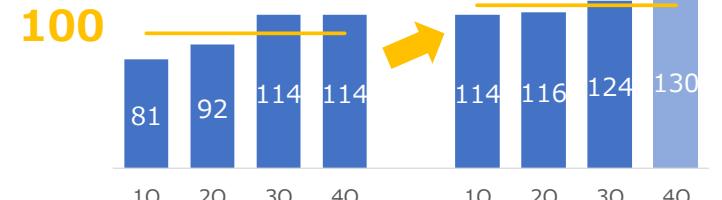
1 半導体用 ターゲット (2024年度実績)



121

AIサーバ需要の増加
に牽引され、
最先端向けに加え、
メモリ向けも好調継続

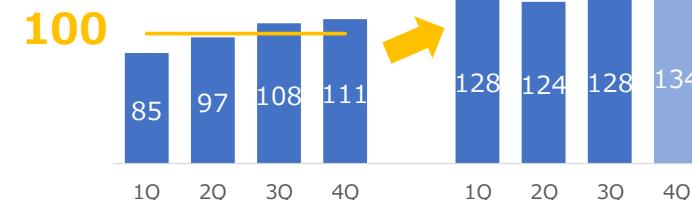
2 薄膜材料 ターゲット



121

データセンター向け
HDD需要の増加を
ドライバに堅調に推移

3 インジウムリン (InP)基板



128

データセンターの成長
拡大に伴い非常に
強い需要が継続

4 *TaNb ターゲット



161

AIサーバ向け用途
での需要が大幅に
増加

前回見通し対比

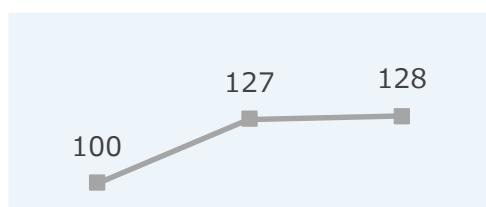
2024年度
実績 2025年度
11月公表 2025年度
2月公表

100 121 121

AIサーバ関連を中心とした
好調な需要が継続も、
一部顧客事情による在庫調整
を踏まえ前回公表並み



データセンター向けHDD需要
は堅調に推移、前回公表並み



生産性の改善を織り込み
上方修正
更なる需要拡大に備えて
設備投資を加速



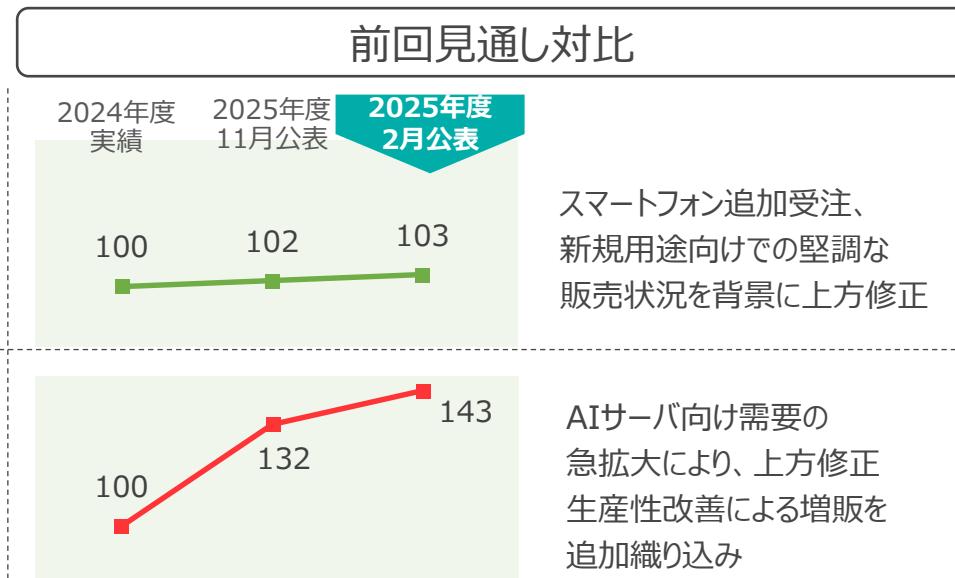
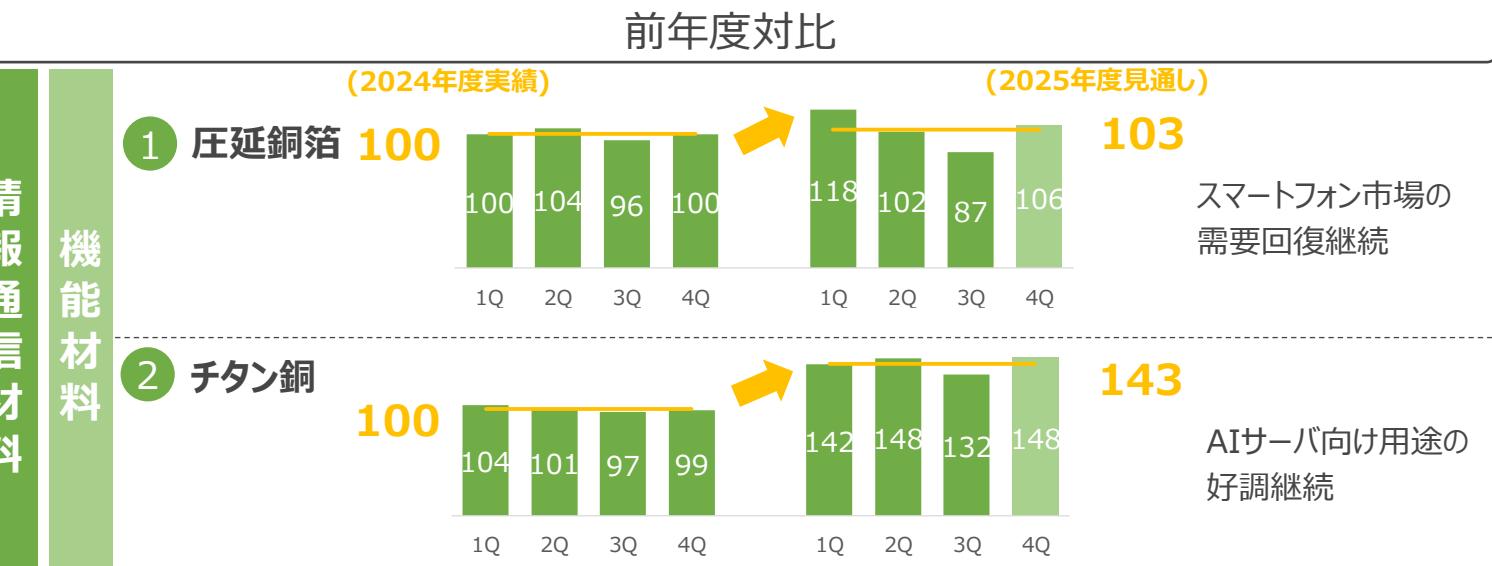
AIサーバ関連の好調な
販売状況を背景に上方修正

*TaNb : タンタル・ニオブ

ハイライト

■ 主な製品 販売数量 (2024年度実績 = 100として指標化)

情報通信材料



■ トピックス (11月~2月の主なリリース)

フォーカス事業

半導体材料

情報通信材料

レゾナック・ハードディスクから
「開発部門表彰」を受賞

結晶材料の増産に向けた設備投資の追加
(→ p.7)

高付加価値製品の開発・生産強化

ベース事業

基礎材料

12月

1月

2月

ケチュア銅プロジェクト権益譲渡(パンパシフィック・カッパー)

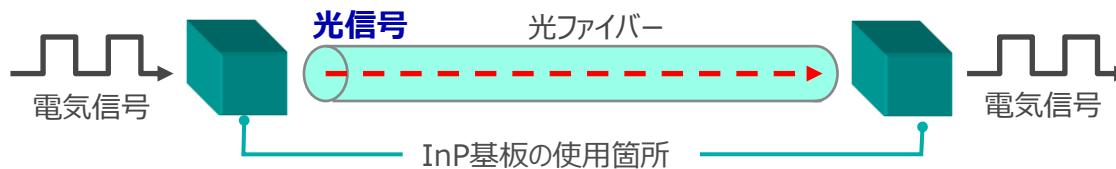
ポートフォリオ改革の推進

ハイライト – トピックス（薄膜材料事業 – InP基板）

- 光通信用途で使用されるインジウムリン（InP）基板は、**データセンター向けで販売好調**
- 急速な市場の拡大を捕捉すべく、**更なる増産に向けた設備投資を決定**
- 今後**データセンター内通信の光化の進展に伴い、更なる成長ポテンシャル**も期待

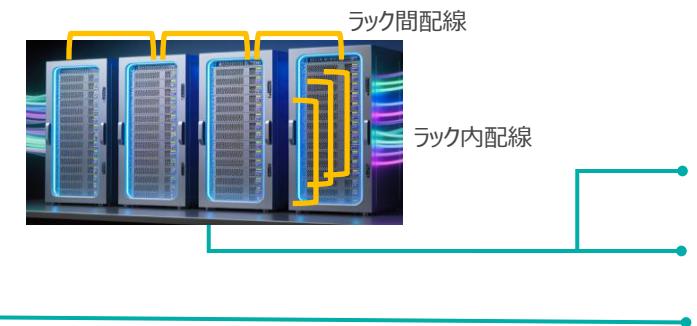
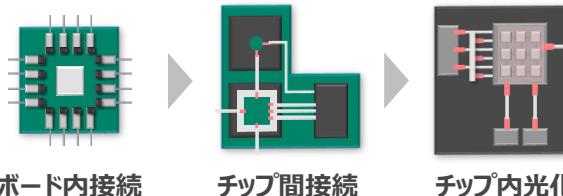
InP基板とは

- 電気信号と光信号の変換を行う光通信用途として、データセンター・インターネット網に使用される材料
- InPは光トランシーバーの受光素子・発光素子に使用される



電気から光へのシフトに伴う成長機会

- 高速通信化・データセンター内の消費電力増加に伴い、近距離向けにも光通信の適用が拡大
- 光通信の適用範囲拡大に伴いトランシーバー使用量が増えることで、当社InP基板の需要も増加



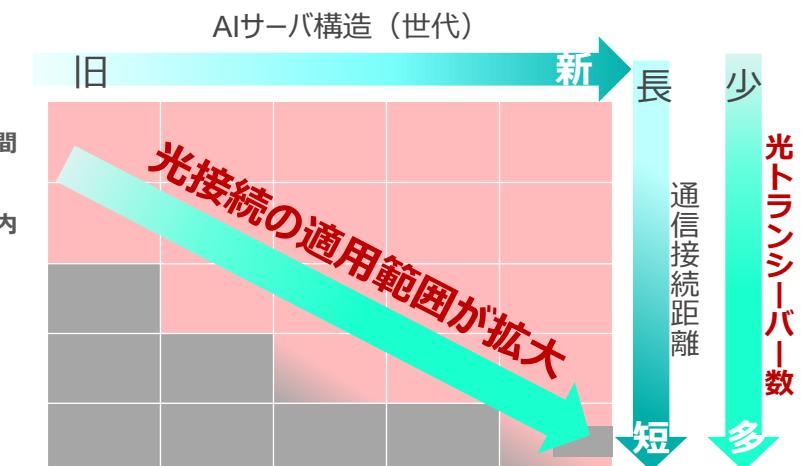
InP収益規模拡大に向けた取り組み

- 26年2月には更なる増強投資を公表。2030年に約3倍（2025年比）の能力増強を行い、基板大型化のニーズにも対応
- 需給タイトな市場環境を好機ととらえ、価格改定を推進中

リリース	生産能力 - 2025年度比	投資額
2025年7月	2割増	約15億円
2025年10月	約5割増 ^{*1}	約33億円
今回	2026年2月 約3倍 ^{*2} (27年度以降順次稼働予定)	約200億円

*1:25年7月リリースと合わせた生産能力 *2:25年7月、10月リリースと合わせた生産能力

■ 光接続 ■ 電気接続

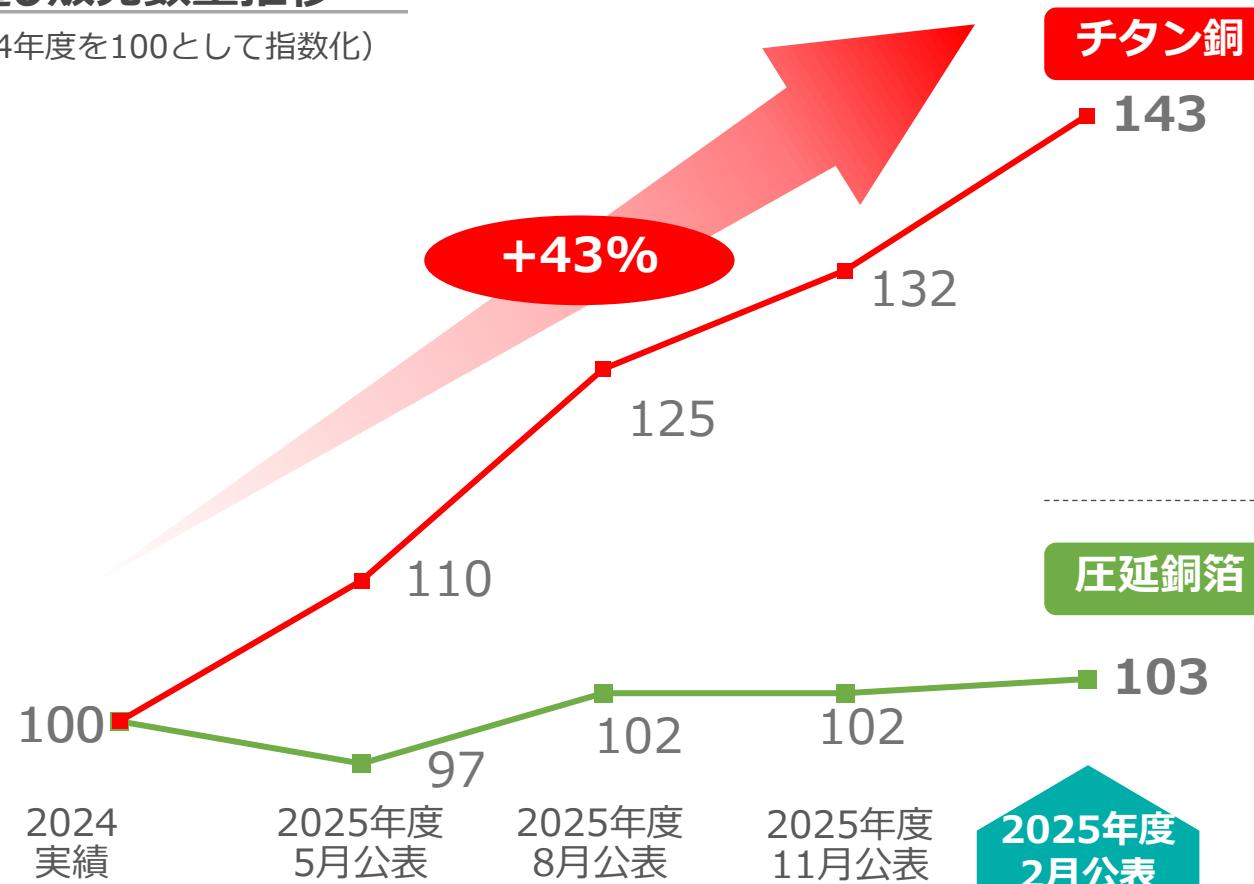


ハイライト – トピックス（機能材料事業）

- ✓ 高付加価値製品である圧延銅箔・チタン銅の販売が好調
- ✓ 特にチタン銅は、AIサーバ向け需要の拡大に伴い、想定を上回る速度で成長

見通し販売数量推移

(2024年度を100として指数化)



- AIサーバ向けコネクタ等の材料としての需要が急増
 - AIサーバは大量のデータ処理に必要な大電流により発熱が大きいため、高強度かつ耐熱性に優れたチタン銅が最適な材料
 - 当社の高度な溶解・熱処理・圧延技術により、耐熱性・耐久性に優れたチタン銅の製造が可能
 - 光通信拡大等、技術トレンドの変化も踏まえ、さらなる成長に向けた取り組みを推進中



- スマートフォン追加受注、新規用途向けで堅調に推移
- スマートフォン用途に加え、スマートグラス・医療分野への採用が進む。ロボティクス・ドローン分野にも用途拡大中



スマートグラス



医療用カテーテル



ロボット



ドローン

ハイライト – トピックス（機能材料事業）

- ✓ ポートフォリオの見直しを実施中（より付加価値の高い製品へ）

機能材料事業について

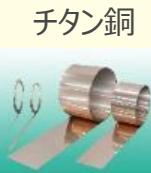
- 主力拠点である倉見工場にて、圧延銅箔やチタン銅をはじめとする高付加価値製品や、りん青銅をはじめとするその他伸銅品を製造
- 高付加価値製品とその他伸銅品が共用する主要設備のキャパシティを成長領域向けに優先配分する、製品ポートフォリオ見直しを実施中
- **りん青銅生産終了により、高付加価値製品へのシフトを一段と加速**

倉見工場



製品例

高付加価値製品等



その他伸銅品

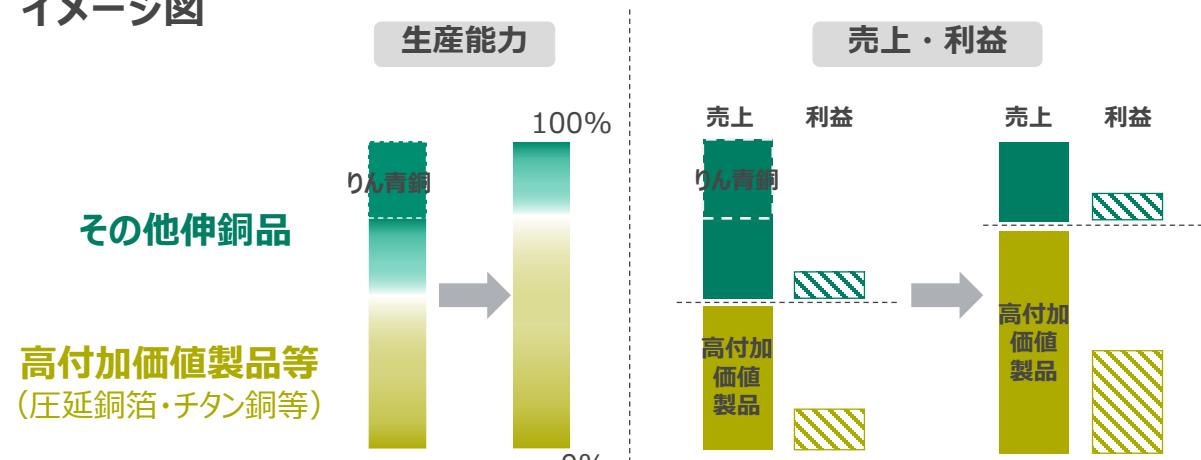
りん青銅



りん青銅の生産終了を決定（2028年3月をもって終了）

- モバイル、データセンター、モビリティ、ロボティクスなどの分野でデバイスの進化が加速
- 当社独自の高い技術力に基づく圧延銅箔やチタン銅をはじめとする高機能・高付加価値製品の需要が増加
- 倉見工場の生産能力を高機能・高付加価値製品の生産に最大限振り向けることで収益力強化を進める

イメージ図



りん青銅分の売上は減少するものの、高付加価値製品への生産能力振り分けにより、利益の増加を期待

ハイライト – トピックス（新規事業領域）

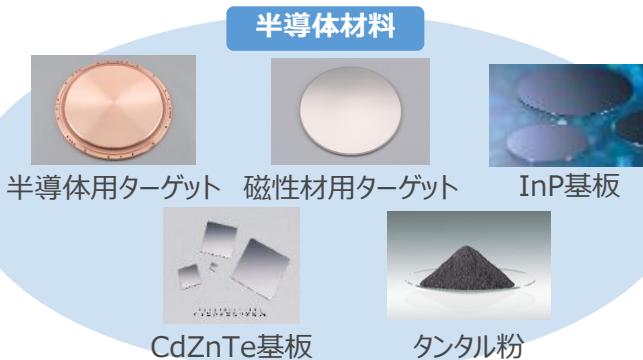
- ✓ 高い成長性により次の収益の柱として期待できる新規事業にも注力することにより製品ポートフォリオを最適化

当社製品（例）

新規事業
主力製品
生産終了

例：CVD/ALDプリカーサ材料

- ✓ 当社の高純度化技術及びTaniobis・東邦チタニウムの塩化技術を活用
- ✓ 次世代のロジック・メモリで期待されている新規プリカーサ材料の開発・量産立ち上げも推進中（24年11月にドイツ拠点に設備導入、稼働を開始）



新規事業の注力領域

次世代半導体

CVD/ALD

先端
パッケージ

エネルギー

電池

触媒

航空・宇宙

ドローン

3Dプリンタ

医療

カテーテル

CT

次世代注目技術

ロボティクス

核融合



グループ会社シナジー(東邦チタニウム・タツタ電線等)を活用し
インオーガニックの成長も含め更なる新規事業領域の拡大を図る

2025年度（2026年3月期） 第3四半期累計実績

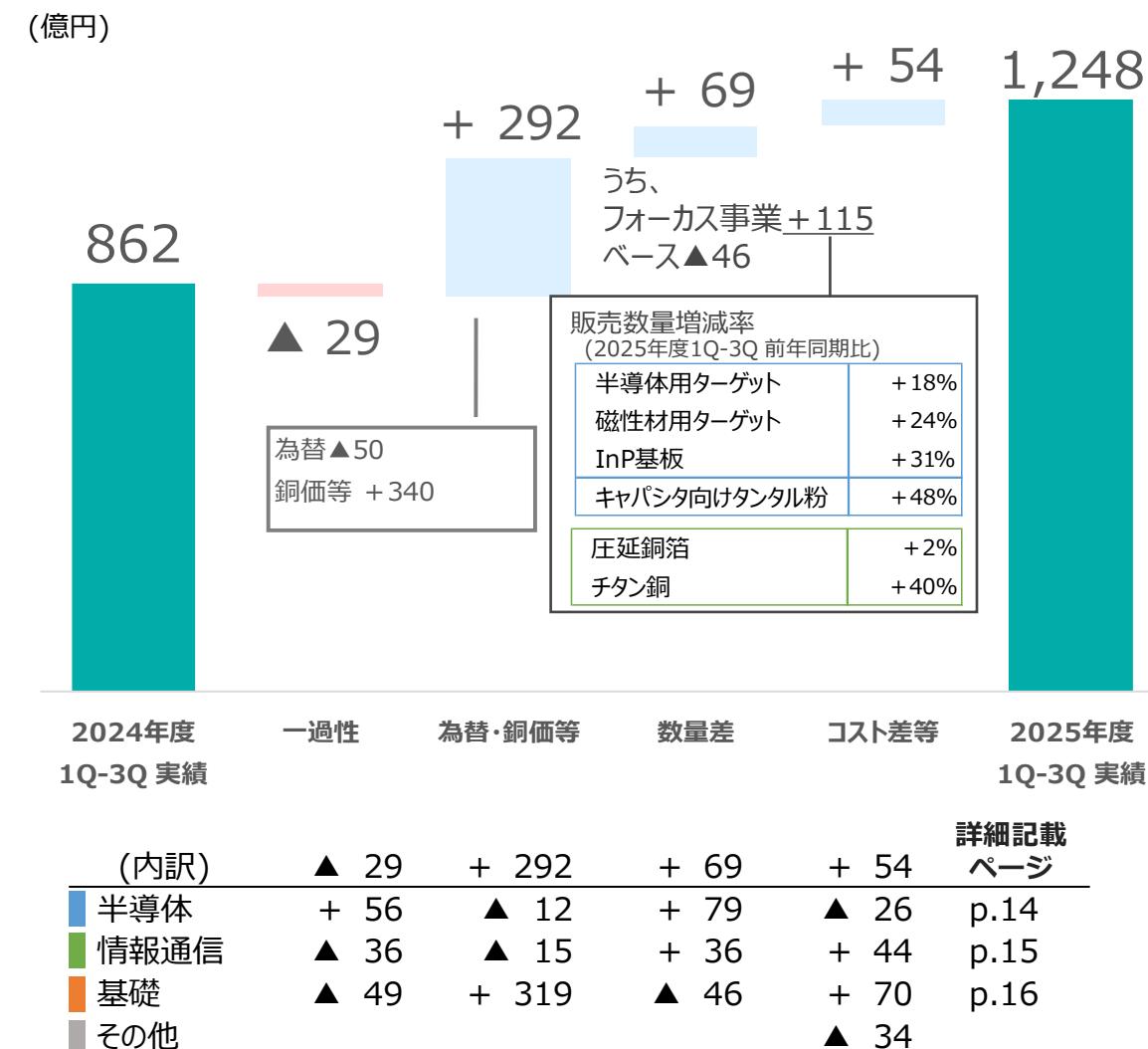
連結損益計算書

(億円)	2024年度	2025年度	前年同期比	
	1Q-3Q 実績	1Q-3Q 実績	差異	増減率
売上高	5,169	6,145	+ 976	+19%
(フォーカス事業)	2,978	3,664	+ 686	+23%
(ベース事業)	2,224	2,577	+ 353	+16%
(その他)	▲ 33	▲ 96	▲ 63	-
営業損益	862	1,248	+ 386	+45%
(フォーカス事業)	411	537	+ 126	+31%
(ベース事業)	508	802	+ 294	+58%
(その他)	▲ 57	▲ 91	▲ 34	-
税引前利益	829	1,209	+ 380	+46%
当期利益	539	956	+ 417	+77%
親会社の所有者に 帰属する当期利益	460	796	+ 336	+73%
為替(円/USD)	153	149	▲ 4	▲3%
LME銅価(¢/lb)	平均	425	460	+ 35
	前期末/当期末	396/395	439/567	+8%

事業セグメント別 売上高及び営業損益

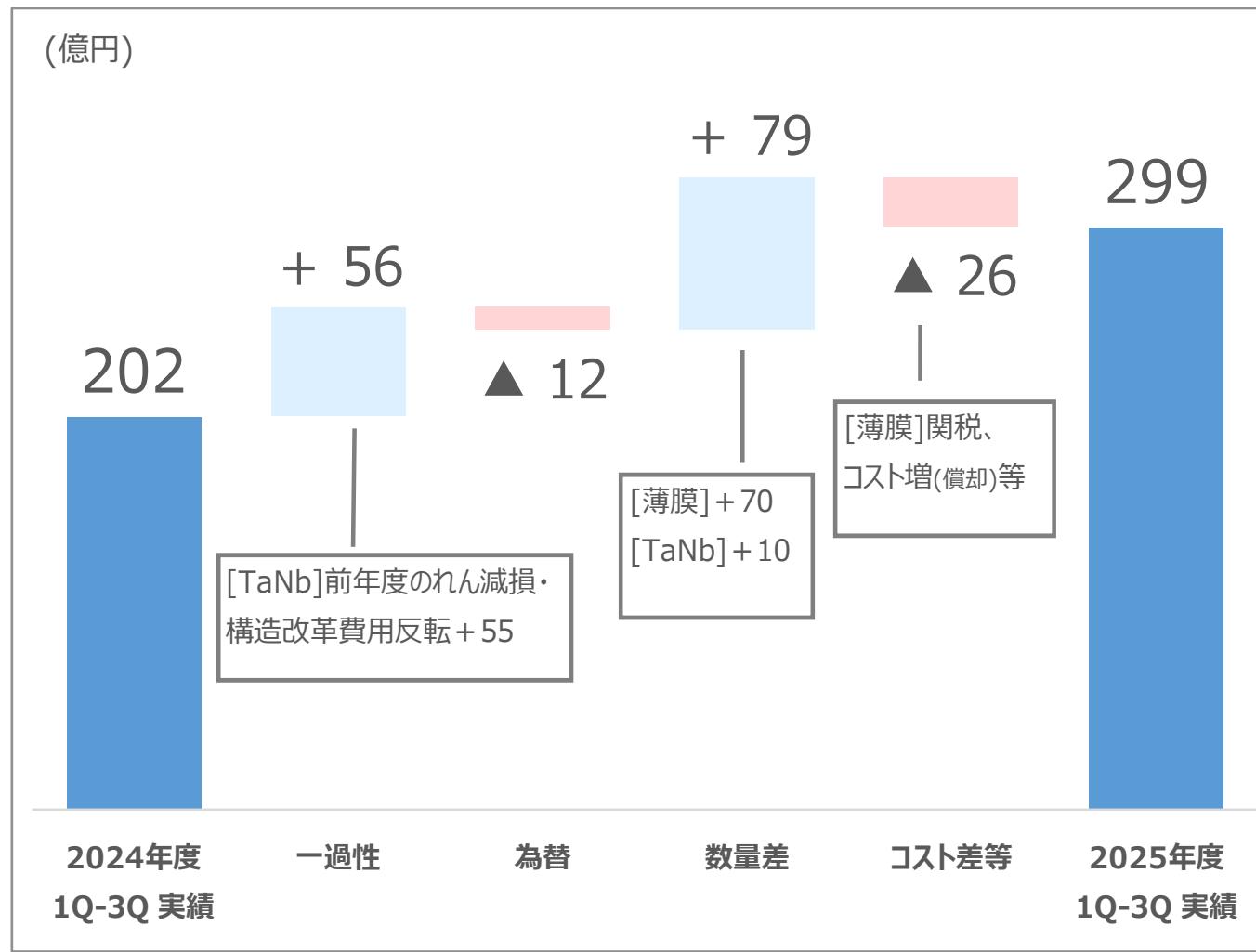
	(億円)	2024年度	2025年度	前年同期比	
		1Q-3Q 実績	1Q-3Q 実績	差異	増減率
フォーカス事業	半導体材料	売上高	1,109	1,302	+ 193 +17%
		営業損益	202	299	+ 97 +48%
	情報通信材料	売上高	1,869	2,362	+ 493 +26%
		営業損益	209	238	+ 29 +14%
ベース事業	基礎材料	売上高	2,224	2,577	+ 353 +16%
		営業損益	508	802	+ 294 +58%
	その他	売上高	▲ 33	▲ 96	▲ 63 -
	事業共通費用等	営業損益	▲ 57	▲ 91	▲ 34 -
合計		売上高	5,169	6,145	+ 976 +19%
		営業損益	862	1,248	+ 386 +45%
(一過性要因除き)			808	1,223	+ 415 +51%
営業損益					

営業損益差異



営業損益差異分析 半導体材料セグメント[2025年度3Q累計実績 対 2024年度3Q累計実績]

営業損益差異分析



事業別概況

薄膜材料

- AI関連需要の拡大を受けた主力製品の増販継続により、為替円高を吸収して増益

タンタル・ニオブ (TaNb)

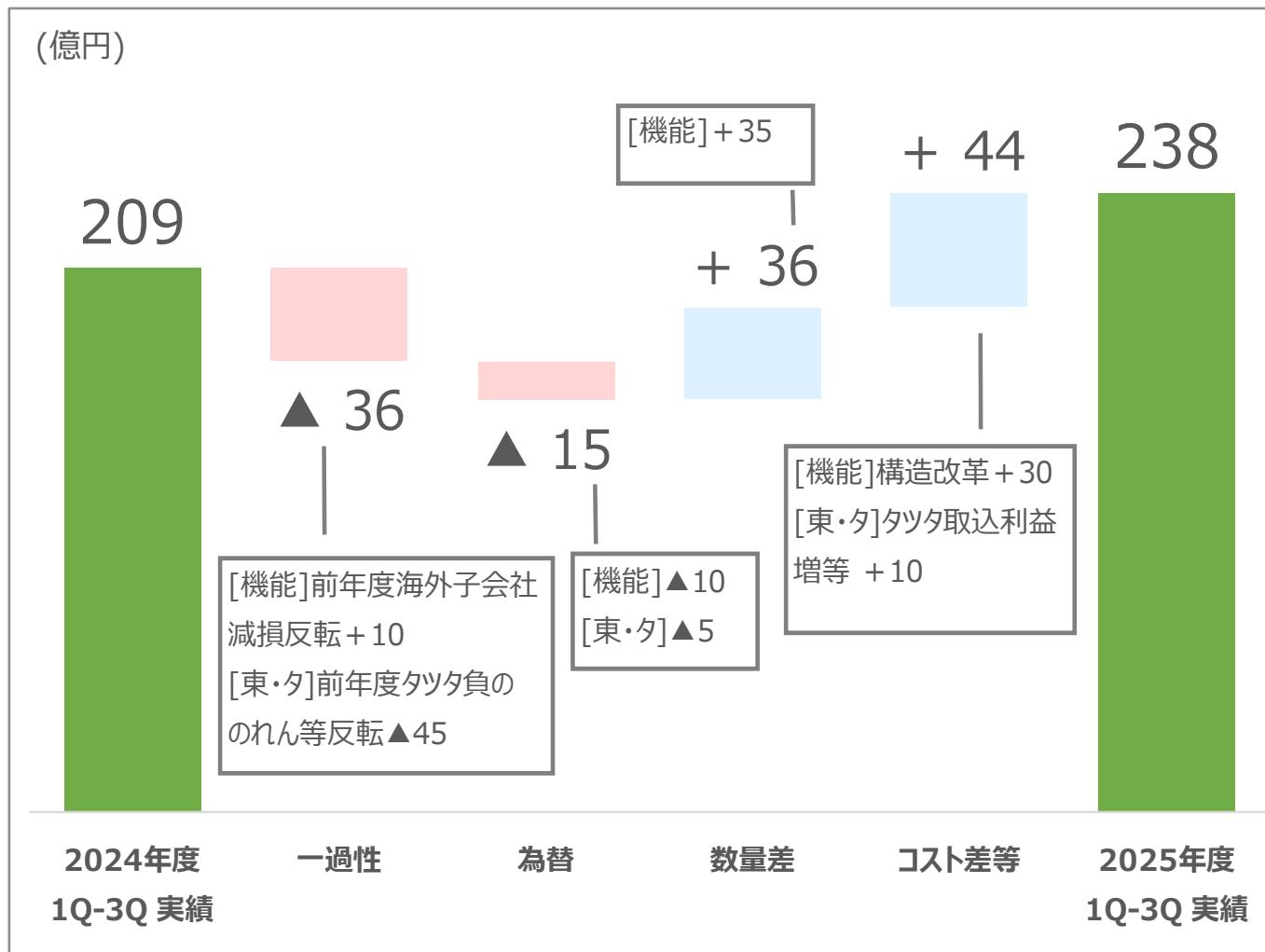
- 前年度のれん減損・構造改革費用の反転に加え、キャパシタ向けタンタル粉の大幅な増販、販売価格改善等により増益

事業別 売上高・営業損益

	億円	2024年度	2025年度	前年同期比	
		1Q-3Q 実績	1Q-3Q 実績	差異	増減率
薄膜材料	売上高	946	1,070	+ 124	+13%
	営業損益	270	304	+ 34	+13%
タンタル・ニオブ (TaNb)	売上高	264	345	+ 81	+31%
	営業損益	▲ 59	4	+ 63	-
調整等	売上高	▲ 101	▲ 113	▲ 12	-
	営業損益	▲ 9	▲ 9	-	-
セグメント合計	売上高	1,109	1,302	+ 193	+17%
	営業損益	202	299	+ 97	+48%

営業損益差異分析 情報通信材料セグメント[2025年度3Q累計実績 対 2024年度3Q累計実績]

営業損益差異分析



事業別概況



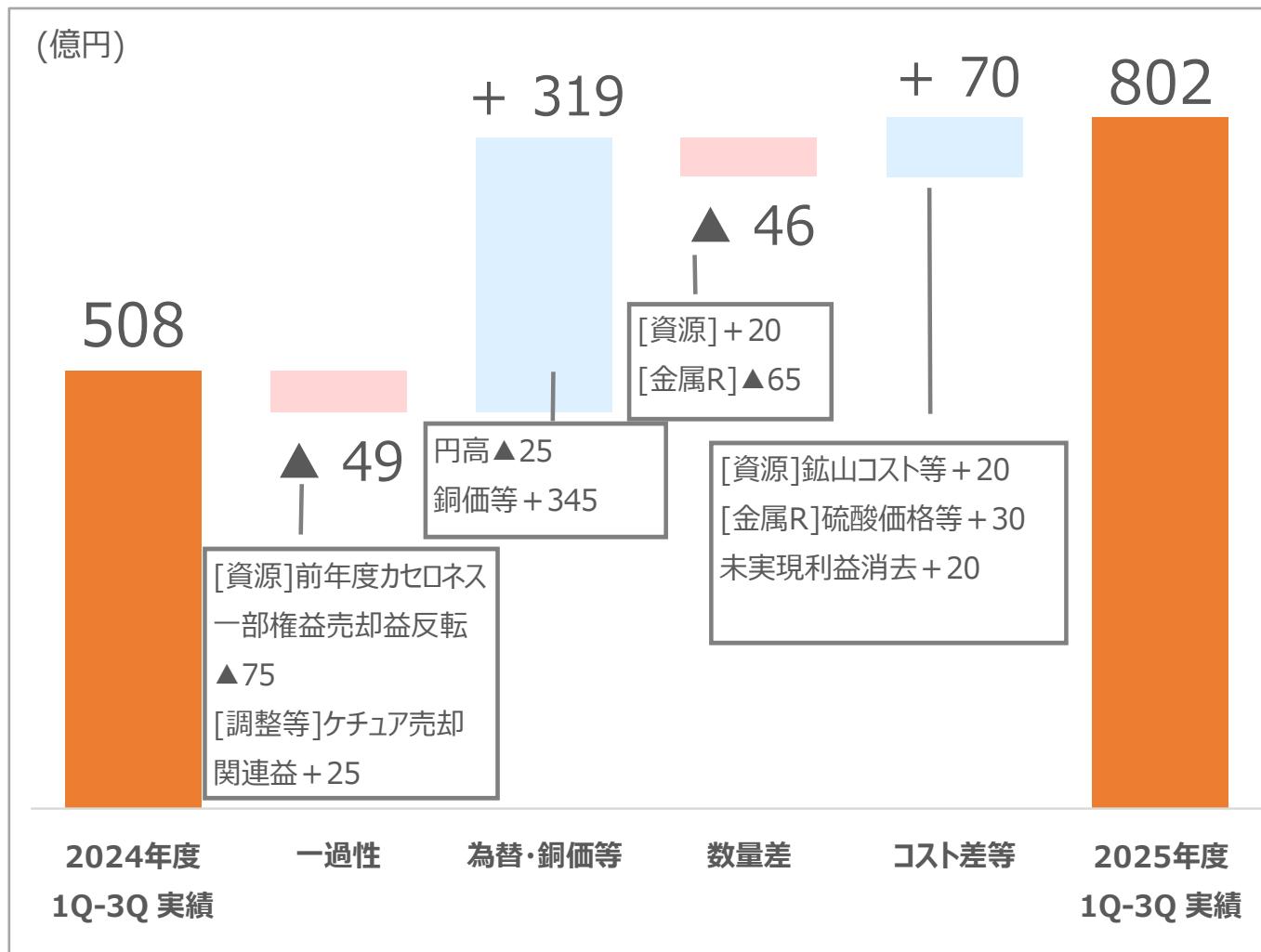
- スマートフォン市場の回復、AIサーバ用途での採用拡大に伴う増販、構造改革(価格改定等)の進展等により為替円高を吸収して大幅増益
- 為替円高、価格影響等により減益
- 前年度計上 負ののれん等の反転を主因に減益

事業別 売上高・営業損益

	億円	2024年度	2025年度	前年同期比	
		1Q-3Q 実績	1Q-3Q 実績	差異	増減率
機能材料	売上高	1,035	1,193	+ 158	+15%
	営業損益	98	161	+ 63	+64%
東邦チタニウム、タツタ電線等	売上高	834	1,169	+ 335	+40%
	営業損益	111	77	▲ 34	▲31%
セグメント合計	売上高	1,869	2,362	+ 493	+26%
	営業損益	209	238	+ 29	+14%

営業損益差異分析 基礎材料セグメント[2025年度3Q累計実績 対 2024年度3Q累計実績]

営業損益差異分析



事業別概況



- 前年度カセロネス権益一部譲渡に伴う売却益反転の一方、銅価等上昇を主因に増益
- 一過性トラブルによる減産はあるものの銅価等上昇を主因に増益
- ケチュア売却関連益により増益

事業別 売上高・営業損益

	億円	2024年度	2025年度	前年同期比	
		1Q-3Q 実績	1Q-3Q 実績	差異	増減率
資源	売上高	25	27	+ 2	+8%
	営業損益	404	595	+ 191	+47%
金属・リサイクル (金属R)	売上高	2,202	2,550	+ 348	+16%
	営業損益	122	195	+ 73	+60%
調整等	売上高	▲ 3	—	+ 3	—
	営業損益	▲ 18	12	+ 30	—
セグメント合計	売上高	2,224	2,577	+ 353	+16%
	営業損益	508	802	+ 294	+58%

*パンパシフィック・カッパーの支配喪失による持分法適用会社化に伴い、2023年度末に未実現利益がすべて実現。2024年度は、利益の消去のみが発生し、一時的に消去額が過多

連結バランスシート・キャッシュフロー/投融資・減価償却費・研究開発費

■ 連結バランスシート

(億円) 2025年3月末

現預金	583	有利子負債	3,013
その他資産	12,247	その他負債	2,699
親会社所有者 帰属持分	6,153	非支配持分	965
ネット有利子負債	2,429		

2025年12月末

現預金	592	有利子負債	3,081
その他資産	13,201	その他負債	3,060
親会社所有者 帰属持分	6,638	非支配持分	1,014
ネット有利子負債	2,489		

フォーカス事業における将来の増産に向けた投資の支出や、
法人税、配当支払い等により、ネット有利子負債増加

■ 連結キャッシュフロー

(億円)

2025年度
1Q-3Q実績

営業キャッシュフロー	932
投資キャッシュフロー	▲ 586
フリーキャッシュフロー	346
財務キャッシュフロー	▲ 352
現金同等物の増減額	▲ 6
為替変動による影響等	14

■ 投融資・減価償却費・研究開発費

	2023年度 実績	2024年度 実績	2025年度 1Q-3Q 実績
投融資	792	923	591
減価償却費	391	440	326
研究開発費	159	178	152

2025年度（2026年3月期） 通期見通し

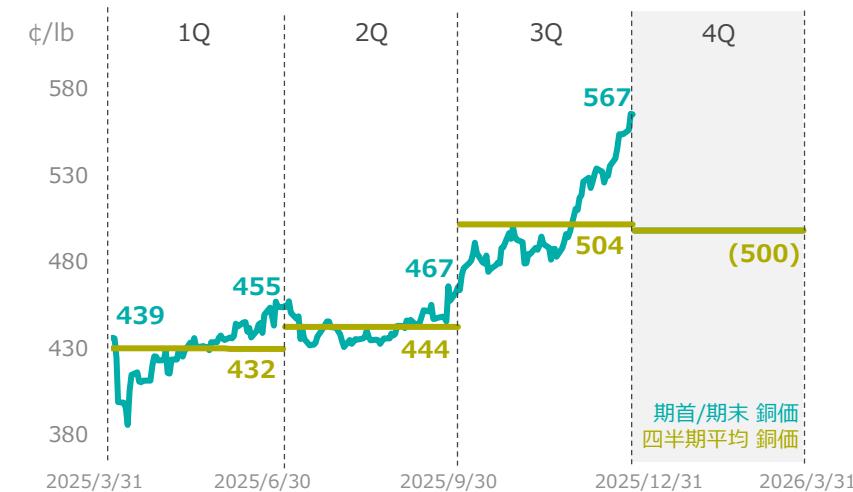
連結損益計算書

(億円)	2025年度	2025年度	前回比	
	11月公表	2月公表	差異	増減率
売上高	7,900	8,200	+ 300	+4%
(フォーカス事業)	4,700	4,900	+ 200	+4%
(ベース事業)	3,200	3,400	+ 200	+6%
(その他)	–	▲ 100	▲ 100	–
営業損益	1,250	1,500	+ 250	+20%
(フォーカス事業)	620	670	+ 50	+8%
(ベース事業)	740	940	+ 200	+27%
(その他)	▲ 110	▲ 110	–	–
税引前利益	1,200	1,440	+ 240	+20%
当期利益	970	1,140	+ 170	+18%
親会社の所有者に 帰属する当期利益	790	930	+ 140	+18%
為替(円/USD)	146	149	+ 3	+2%
LME銅価(¢/lb)	平均	436	470	+ 34 +8%
前期末/当期末	439/435	439/500		

為替・銅価前提*

- 為替 : 145円/USD
- LME銅価 : 500¢/lb

銅価前提 推移



営業利益感応度 (4Q)

単位 : 億円	為替 5円円安	銅価 +10¢/lb
フォーカス事業	+ 5	–
ベース事業	+ 10	+ 20
合計	+ 15	+ 20

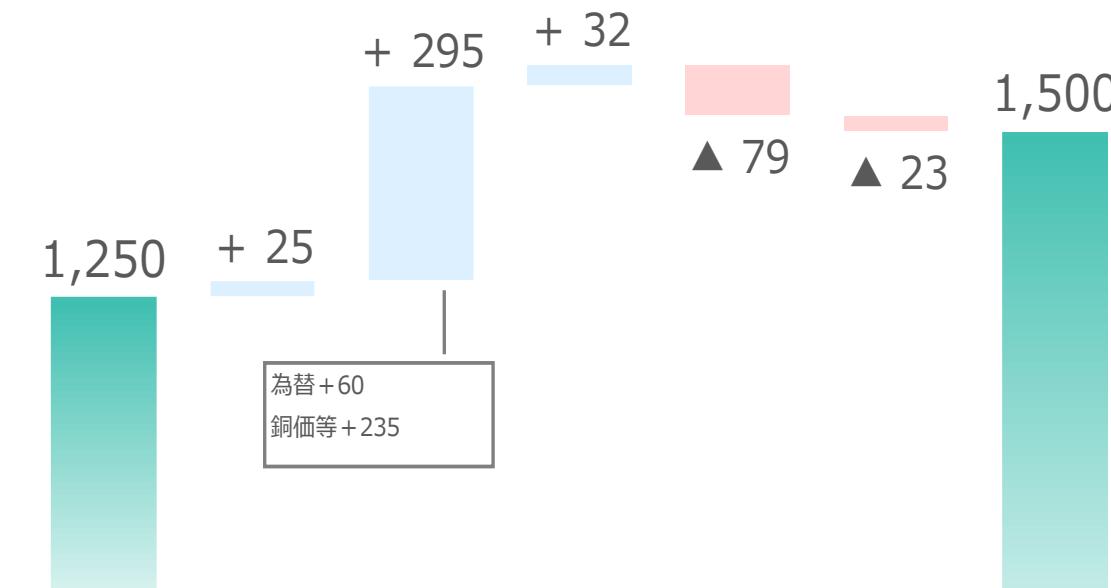
*対象期間 為替 : 2月～3月、銅価 : 1月～3月

事業セグメント別 売上高及び営業損益

		(億円)	2025年度	2025年度	前回比		
			11月公表	2月公表	差異	増減率	
フォーカス事業	半導体材料	売上高	1,700	1,800	+ 100	+6%	
		営業損益	400	400	-	-	
ベース事業	情報通信材料	売上高	3,000	3,100	+ 100	+3%	
		営業損益	220	270	+ 50	+23%	
その他	基礎材料	売上高	3,200	3,400	+ 200	+6%	
		営業損益	740	940	+ 200	+27%	
	事業共通費用等	売上高	-	▲ 100	▲ 100	-	
		営業損益	▲ 110	▲ 110	-	-	
合計		売上高	7,900	8,200	+ 300	+4%	
合計		営業損益	1,250	1,500	+ 250	+20%	

営業損益差異

(億円)

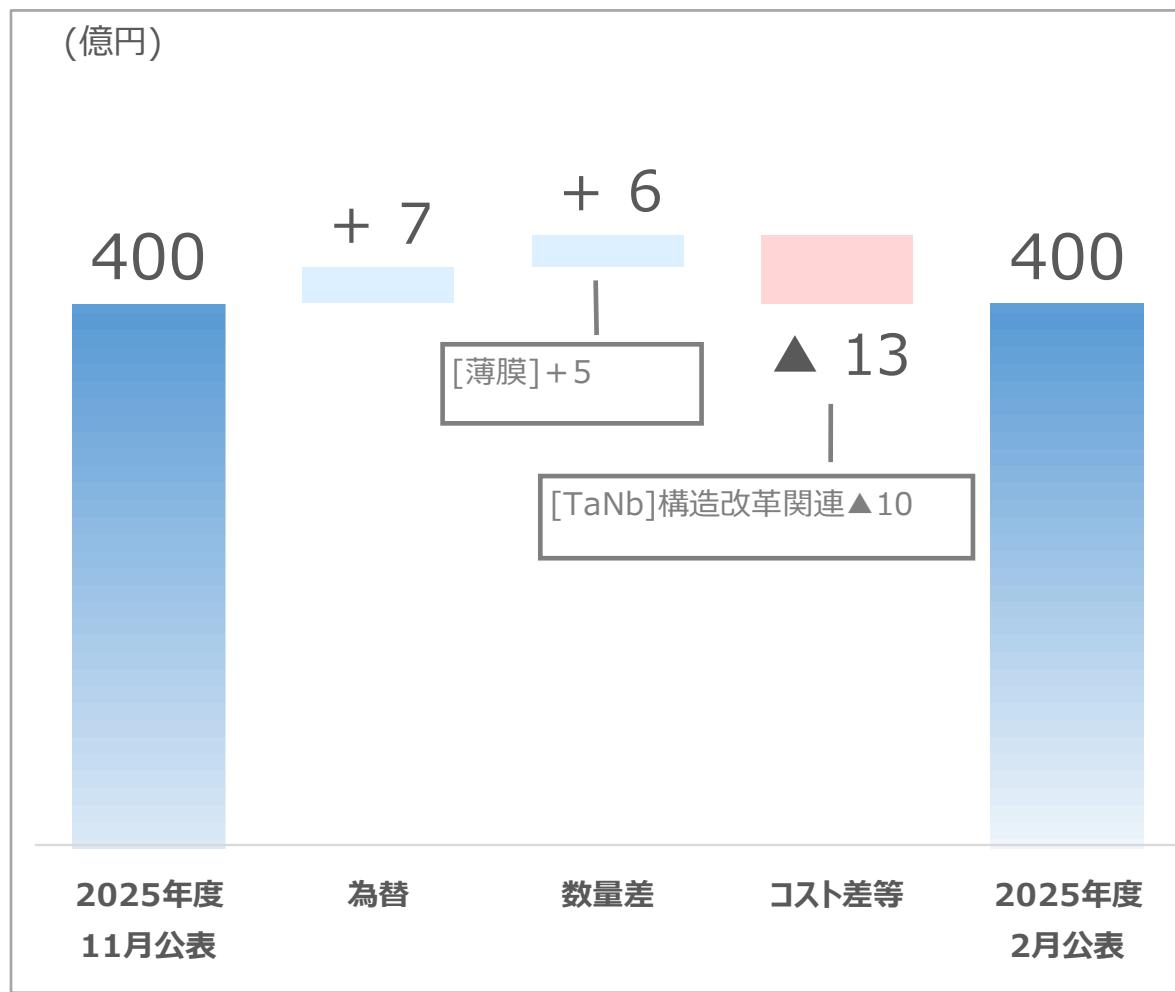


2025年度 11月公表	一過性	為替・銅価等	数量差 (フォーカス事業)	数量差 (ベース事業)	コスト差等	2025年度 2月公表
-----------------	-----	--------	------------------	----------------	-------	----------------

	(内訳)	+ 25	+ 295	+ 32	▲ 79	▲ 23	詳細記載 ページ
半導体	-	+ 7	+ 6	+ 6	▲ 13	▲ 13	p.21
情報通信	-	+ 15	+ 26	+ 26	+ 9	+ 9	p.22
基礎	+ 25	+ 273	▲ 79	▲ 79	▲ 19	▲ 19	p.23
その他	-	-	-	-	-	-	-

営業損益差異分析 半導体材料セグメント[2025年度見通し 2月公表 対 11月公表]

営業損益差異分析



事業別概況



- 半導体用ターゲット等の増販および為替円安を主因に増益
- キャパシタ向けタンタル粉増販の一方、構造改革関連費用織り込みにより減益

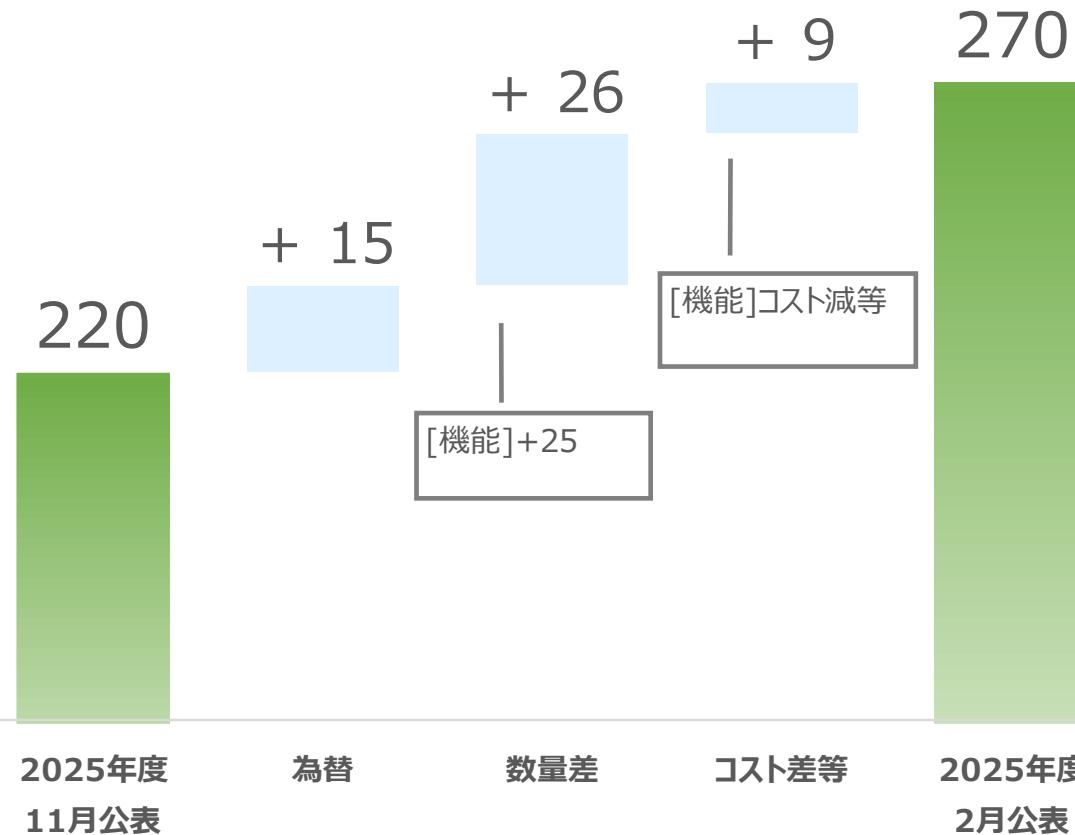
事業別 売上高・営業損益

	億円	2025年度	2025年度	前回比	
		11月公表	2月公表	差異	増減率
薄膜材料	売上高	1,400	1,500	+ 100	+7%
	営業損益	400	410	+ 10	+3%
タンタル・ニオブ (TaNb)	売上高	500	500	-	-
	営業損益	-	▲ 10	▲ 10	-
調整等	売上高	▲ 200	▲ 200	-	-
	営業損益	-	-	-	-
セグメント合計	売上高	1,700	1,800	+ 100	+6%
	営業損益	400	400	-	-

営業損益差異分析 情報通信材料セグメント[2025年度見通し 2月公表 対 11月公表]

営業損益差異分析

(億円)



事業別概況

機能材料

- 圧延銅箔、AIサーバ向けチタン銅の増販、為替円安等により増益

東邦チタニウム、タツタ電線等

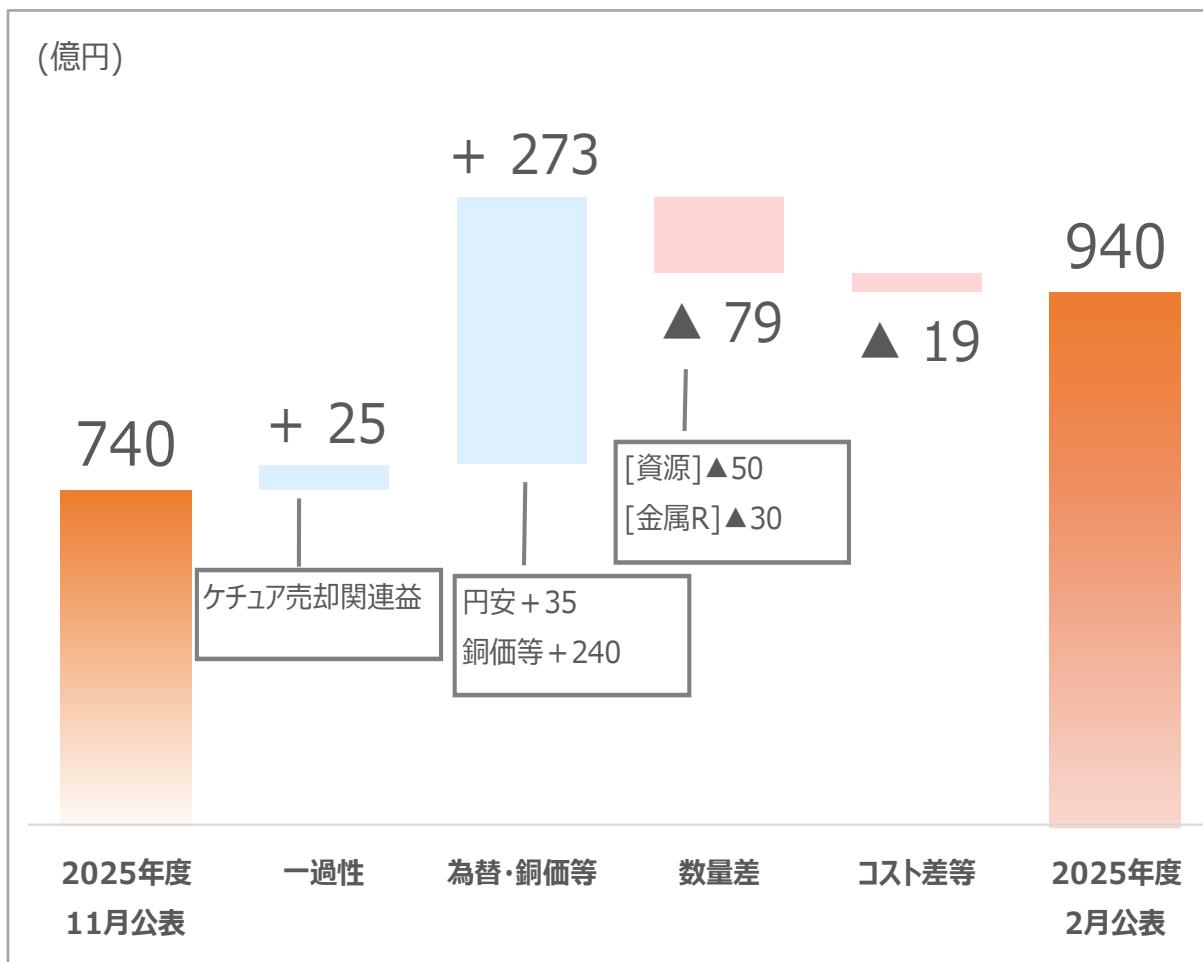
- 為替円安等により増益

事業別 売上高・営業損益

	億円	2025年度	2025年度	前回比	
		11月公表	2月公表	差異	増減率
機能材料	売上高	1,500	1,600	+ 100	+7%
	営業損益	160	200	+ 40	+25%
東邦チタニウム、 タツタ電線等	売上高	1,500	1,500	-	-
	営業損益	60	70	+ 10	+17%
セグメント合計	売上高	3,000	3,100	+ 100	+3%
	営業損益	220	270	+ 50	+23%

営業損益差異分析 基礎材料セグメント[2025年度見通し 2月公表 対 11月公表]

営業損益差異分析



事業別概況

資源
金属・リサイクル
調整等

- 円安や銅価等上昇、
ケチュア売却関連益織り込みにより増益

事業別 売上高・営業損益

	億円	2025年度	2025年度	前回比	
		11月公表	2月公表	差異	増減率
資源	売上高	—	—	—	—
	営業損益	530	650	+ 120	+23%
金属・リサイクル (金属R)	売上高	3,200	3,400	+ 200	+6%
	営業損益	190	260	+ 70	+37%
調整等	売上高	—	—	—	—
	営業損益	20	30	+ 10	+50%
セグメント合計	売上高	3,200	3,400	+ 200	+6%
	営業損益	740	940	+ 200	+27%

2025年度見通し 連結バランスシート・キャッシュフロー/株主還元

■ 連結バランスシート

2025年3月末
(実績)

(億円)

現預金
583
有利子負債
3,013

その他負債
2,699

その他資産
12,247
親会社所有者
帰属持分
6,153

非支配持分
965

ネット有利子
負債

2,429

2026年3月末
(2月公表見通し)

現預金
550
有利子負債
3,290

その他負債
2,820

その他資産
13,370
親会社所有者
帰属持分
6,810

非支配持分
1,000

2026年3月末
(11月公表見通し)

現預金
490
有利子負債
3,180

その他負債
2,540

その他資産
12,860
親会社所有者
帰属持分
6,620

非支配持分
1,010

2,690

■ 連結キャッシュフロー

2025年度
見通し

営業キャッシュフロー
1,010

投資キャッシュフロー
▲ 850

フリー・キャッシュフロー
160

財務キャッシュフロー
▲ 200

現金同等物の増減額
▲ 40

為替変動による影響等
0

ENEOSホールディングス(株)保有
当社株式について

今後、仮に更なる株式の放出
がある場合には、資産売却等
を含む調達資金による自社株
買いも選択肢の一つとして
検討していく

■ 株主還元

配当方針

連結配当性向20%程度を
基本とした上で、当社の想定
対比で銅価が上昇した結果
として、ベース事業の利益が
上振れた分については、その
一部も株主に還元する方針

	2025年 3月期	2026年3月期 (予定)	
		11月公表時	2月公表
1株あたり 配当金 ※2	18円 ※1	21円	27円
中間 6円		15円	21円
期末 配当性向 ※2	24%	25%	27%

※1 2024年11月に実施した配当(850億円)は除く
※2 銅価上昇を反映

Appendix

フォーカス事業

- 4月 インド現地法人を設立
- 5月 ひたちなか新工場（仮称）に隣接する工業用地の新規取得を決定
- 6月 次世代半導体の高性能化に不可欠な高純度CVD・ALD材料の供給体制を強化 —急速な成長を遂げる生成AIのさらなる進化に貢献—
- 7月 経済産業省による半導体用スパッタリングターゲットに係る供給確保計画の認定について
- 7月 結晶材料の増産に向けた設備投資の決定
- 9月 次世代半導体パッケージのコンソーシアム「JOINT3」に参画
- 9月 パナソニックグループとの使用済み家電からの銅資源循環スキームの共創を開始
- 9月 「データインフラ材料事業推進部」新設
- 10月 結晶材料の増産に向けた設備投資の追加の決定
- 10月 レーザー核融合スタートアップの株式会社EX-Fusionへの出資決定
- 11月 Alloyed社グループによる新型3Dプリント・マイクロタービンの開発・試験成功
- 12月 株式会社レゾナック・ハードディスクから「開発部門表彰」を受賞
- 1月 りん青銅条の生産終了の決定
- 2月 結晶材料の増産に向けた設備投資の追加の決定

ベース事業

- 6月 豪州ミネラルサンド鉱床開発プロジェクト参画に向けた契約締結 — レアメタル資源の長期安定確保に向けて —
- 6月 金属・リサイクル事業の収益力強化に向けた方向性について
- 9月 リサイクル原料の増処理に向けた設備投資の決定
- 11月 Copi PJ(豪州ミネラルサンド鉱床開発プロジェクト)の開発評価への参加を丸紅が決定
- 11月 パンパシフィック・カッパーと三菱マテリアルの銅精鉱の購入・電気銅等の販売に係る事業の統合に関する基本合意書を締結
- 12月 ケチュア銅プロジェクト権益譲渡

役員 株式報酬制度(RS信託)／従業員 株式給付信託(J-ESOP-RS) の導入

役員報酬制度の概要

- 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）及び執行役員については、固定報酬（現金報酬）、短期業績連動報酬（STI：現金報酬）及び長期業績連動報酬（LTI：株式報酬）で構成
 - ✓ 全体的に業績連動比率を高めつつ、各役位の職責に鑑み、役位に応じた段階的な変動
 - ✓ 株式報酬は、業績連動部分と固定部分で構成（譲渡制限を付す）
- 監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみで構成（監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議により決定）
- 役員報酬制度とは別途、役員持株会を設立済みであり、各役員は相応の金額を拠出済み

当社役員報酬の構成比率

■ 固定(金銭) ■ STI業績連動(金銭) ■ LTI業績連動(株式) ■ LTI固定(株式)



■ 持株数【単位：万株】 (持株比率)

2025年12月末時点	
役員持株会+株式報酬	24 (0.0%)
従業員持株会+株式給付信託	209 (0.2%)

従業員 株式給付信託の概要

- 一定の要件を満たした管理職従業員に対し株式を給付
 - ✓ 業績・株価向上を目指した業務遂行を促し、ひいてはこれにともなう中長期的な企業価値の向上を図る（譲渡制限を付す）

半導体・情報通信分野に欠かせない先端素材をマーケットに供給するグローバルトップメーカー

事業・主力製品

高度な技術的差別化の実現により、グローバル競争優位性を持つ当社成長戦略のコア事業 ★AIサーバ関連

半導体材料

薄膜材料

半導体用ターゲット ★



半導体ウエハにナノレベルの膜を形成するために必要な金属材料

カドミウム・ジンク・テルル

CdZnTe基板



放射線・赤外線センサ素子に使用される単結晶基板

磁性材用ターゲット ★



64%*1

大容量ハードディスクドライブに膜を形成するために必要な金属材料

CVD⁴/ALD⁵プリカーサ材料



CVD/ALDによる薄膜形成に使用される金属原料

情報通信材料

インジウムリン InP基板 ★



光通信用の受発光素子材料

タンタル・ニオブ

タンタル粉



半導体用ターゲットやキャパシタに使用される金属粉末

機能材料

圧延銅箔



78%*2

FPC (フレキシブルプリント基板)³に用いられる屈曲性に優れた金属箔

タツタ電線

チタン銅 ★



強度・導電性・曲げ加工性に優れた合金材料

電磁波シールドフィルム



モバイル機器の回路を電磁波ノイズから保護する機能性フィルム

最終用途例

AIサーバ



ウェアラブル



スマートフォン



モビリティ
(xEV/ADAS)



銅、レアメタル（タンタル、チタンなど）のサプライチェーン強化を通じて、フォーカス事業の成長を支える

注1：富士経済「2024年 半導体材料市場の現状と将来展望」（2023年実績、AI系を除く半導体用ターゲット市場における当社のシェア、販売金額ベース）；注2：富士キメラ総研「2024 エレクトロニクス実装ニューマテリアル便覧」（2023年実績、FPC向けのみ、出荷数量ベース）；注3：FPC(Flexible Printed Circuits)：絶縁性を持ったベースフィルムと銅箔等の導電性金属を貼り合わせた基材に電気回路を形成した基板；注4：Chemical Vapor Deposition；注5：Atomic Layer Deposition

長期ビジョン・沿革

●長期ビジョン策定

● 基本方針

「装置産業型企業」から「技術立脚型企業」への転身により、激化する国際競争の中にもあっても高収益体质を実現、半導体材料／情報通信材料のグローバルリーダーとして、持続可能な社会の実現に貢献する

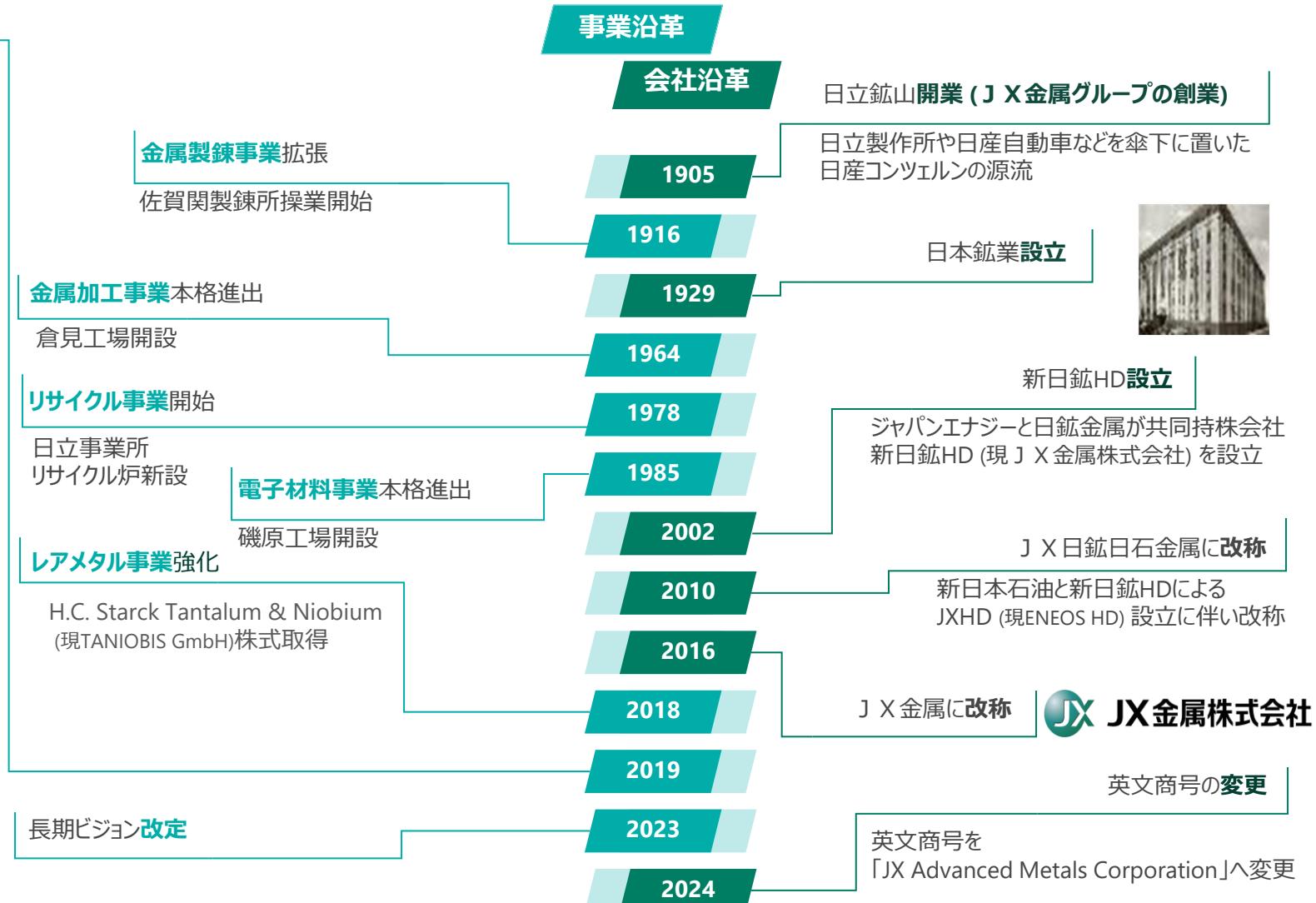
● 目指すポートフォリオ

【成長】フォーカス事業

- 成長戦略のコアとして位置づけ
- 技術による差別化によりグローバル競争で優位に立ち、市場成長以上の利益成長を図る

【基盤】ベース事業

- サプライチェーン強化を通じてフォーカス事業の成長を支える
- 半導体材料／情報通信材料に不可欠な銅及びレアメタルを中心ドメインと位置付ける



中長期事業目標

✓ 目標達成に向け、着実に進捗中

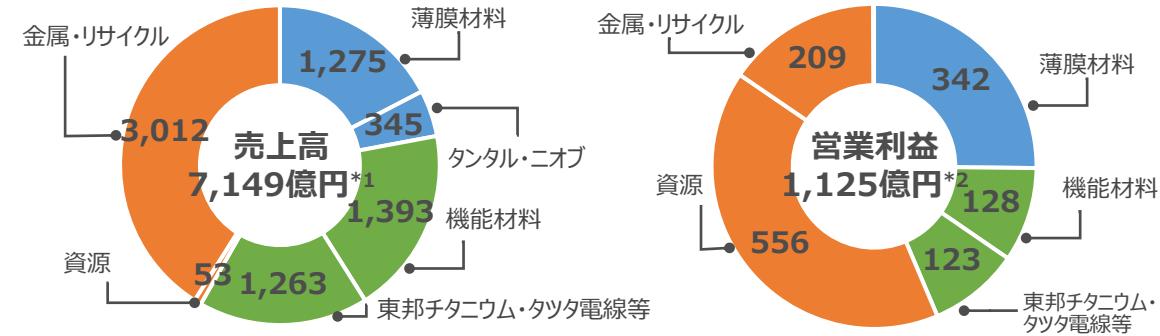
		2023年度	2024年度	2025年度	2027年度
		実績	実績	見通し	目標
営業利益	[連結] (YoY成長率)	862 億円	1,125 億円	1,500 億円	CAGR10%~15% (2023年度-2027年度)
	[フォーカス事業] (YoY成長率)	273 億円	518 億円	670 億円	
	[連結]	5.7%	15.7%	18.3%	12%~17%
	[フォーカス事業]	8.8%	12.5%	13.7%	15%~20%
営業利益率	[半導体材料セグメント]	21.4%	18.0%	22.2%	25%~30%
	[情報通信材料セグメント]	0.5%	9.5%	8.7%	8%~13%
	[連結]	26%	41%	42%	67%以上
	[半導体材料セグメント]	25%	21%	25%	45%以上
営業利益構成比率	[フォーカス事業]	18.3%	11.0%	14.3%	10%以上
ROE	NET Debt/EBITDA倍率	2.6倍	1.6倍	1.4倍	1.5倍未満

主な製品一覧

主な製品（写真）



サブセグメント別 売上高/営業損益（2024年度）



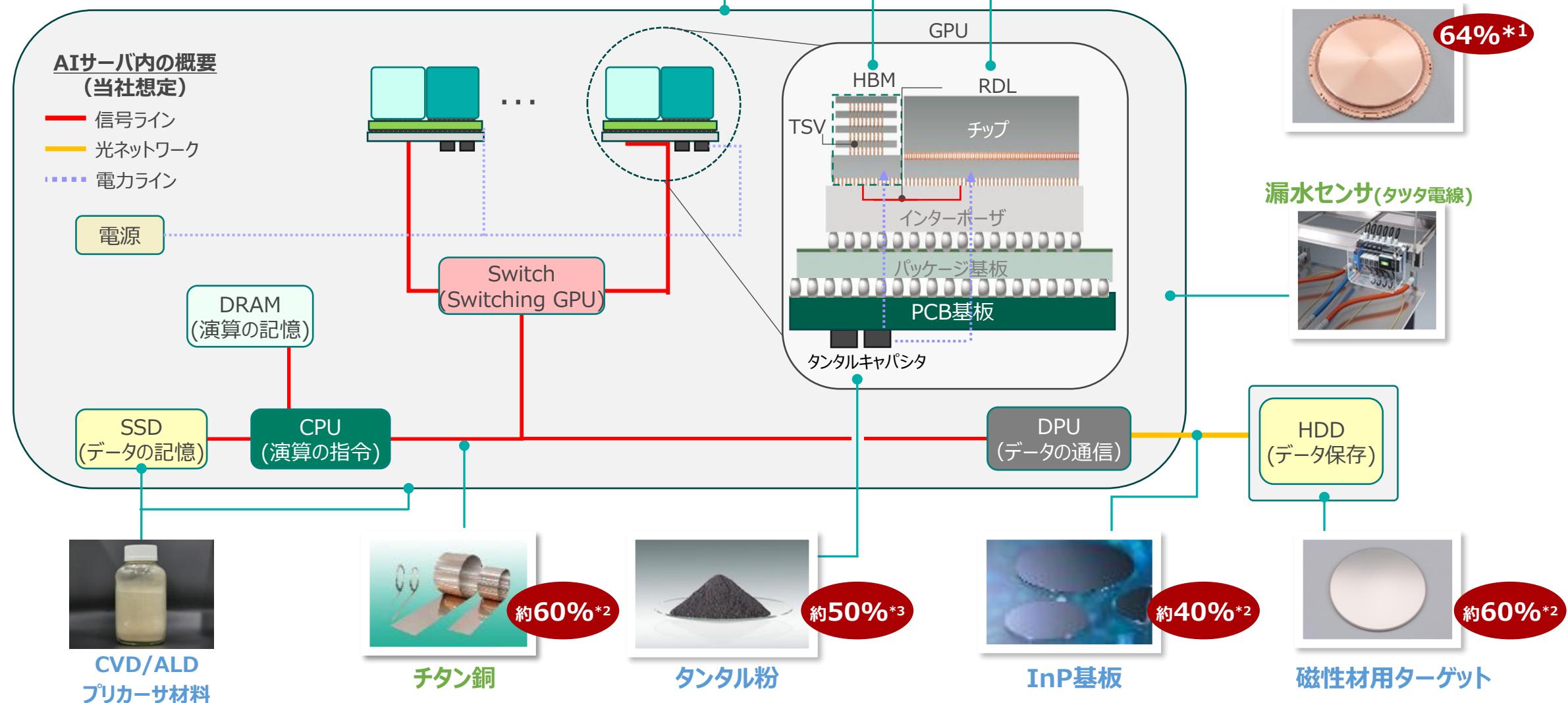
セグメント	サブセグメント	主な製品	主要用途	最終用途例
フォーカス事業	半導体材料	薄膜(はくまく)材料	半導体用ターゲット 磁性材用ターゲット インジウムリン（InP）基板 カドミウム・ジンク・テルル（CdZnTe）基板 CVD・ALD用材料	半導体ウエハ上の金属薄膜形成 磁気記録メディア上の金属薄膜形成 光 ⇄ 電気の変換（受発光素子） 赤外線検知、放射線検知 半導体用配線材料
		タンタル・ニオブ	スパッタリングターゲット向けタンタル粉 キャパシタ向けタンタル粉	半導体用ターゲット向け材料 タンタルキャパシタ向け材料
		機能材料	圧延銅箔 チタン銅	FPC（フレキシブルプリント基板）用材料 コネクタ用材料、カメラばね用材料
		東邦チタニウム・タツタ電線	（東邦チタ） （タツタ） スponジチタン 化学品（超微粉ニッケル） THC触媒 インフラ・産業機器用電線 電磁波シールドフィルム	航空機エンジン部品、機体材料 積層セラミックコンデンサ（MLCC）内部電極向け材料 ポリプロピレン、ポリオレフィン製造用触媒 電線向け材料 電子モバイル機器の内部回路保護
				航空機、化学・電力プラント 積層セラミックコンデンサ
	情報通信材料	資源	銅精鉱・電気銅・モリブデン精鉱 (持分比率) カセロネス銅鉱山：30% ロス・ペランブレス銅鉱山：12.52% エスコンディーダ銅鉱山：3%	-
		金属・リサイクル	電気銅、型銅、貴金属、硫酸 (持分比率) パンパシフィック・カッパー：47.8%	-
				自動車内外装、家電製品、包装材
				発電所・プラント向け電線・ケーブル
				スマートフォン
ベース事業				

当社データセンター関連製品

半導体材料

機能材料

グローバルシェア



*1：富士経済「2024年 半導体材料市場の現状と将来展望」（2023年実績、AI系を除く半導体用ターゲット市場における当社のシェア、販売金額ベース） *2：当社推定

*3：当社推定。スパッタリングターゲット向け含む

半導体用ターゲットについて

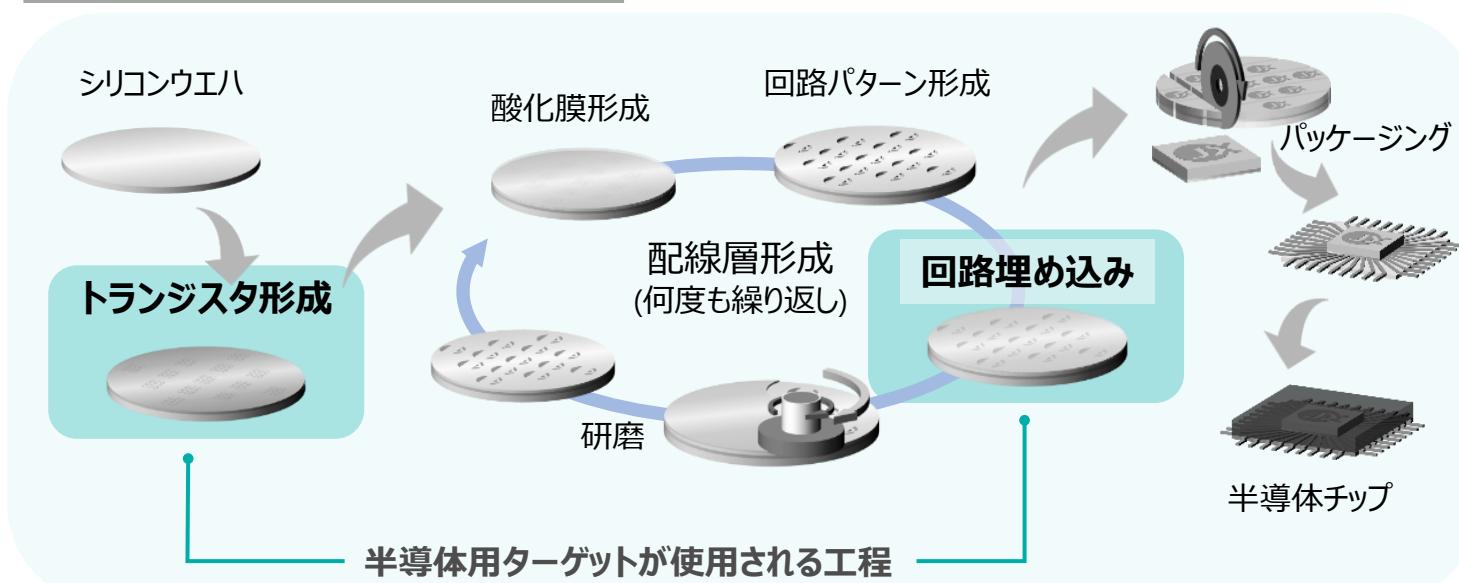
半導体用ターゲットとは



世界シェア
約6割

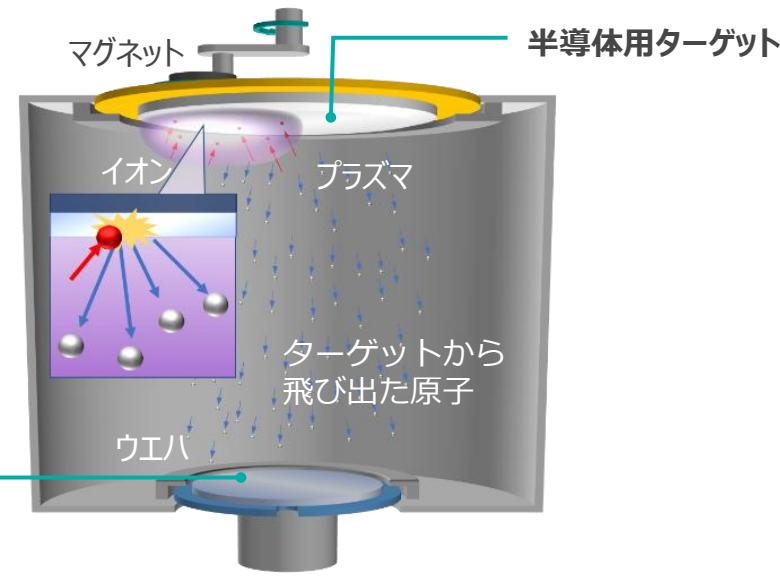
シリコンウェハ上にトランジスタや配線層を形成するためのPVD^{*1}工程で必要となる高純度の金属材料

半導体チップ製造における使用工程

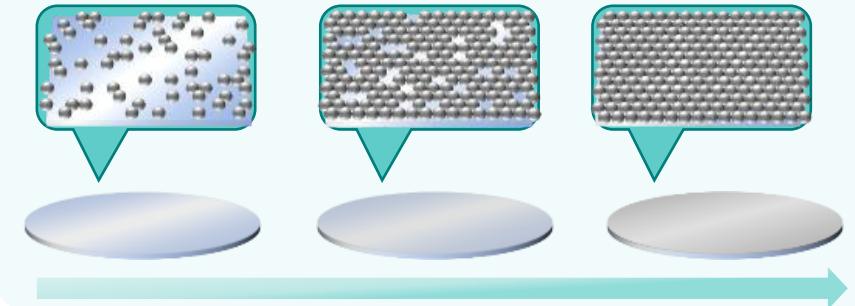


使用過程・構造

(スパッタチャンバー内部模式図)



スパッタリングプロセスで膜が形成される様子(模式図)



*1 Physical Vapor Deposition (物理気相成長法) の略。金属材料を気化させて基板に成膜する方法。スパッタリング法は代表的なPVDプロセスのひとつ

グローバルトップシェアを実現する当社半導体用ターゲットの強み

技術力の高さやメーカー・顧客との関係性、グローバルな生産体制を完備し、グローバルトップシェアを実現

世界トップクラスの 技術力

高純度化、組成・組織制御、
表面処理、分析評価などで高い
技術力を保有



世界最高レベルの
高純度銅
**純度
99.999999%**

半導体製造装置メーカー との強固な関係

装置メーカーとの関係構築を通じて
装置の標準材料への指定を獲得



J X 金属



装置メーカー

顧客(半導体メーカー) との信頼関係

長年にわたる取引実績を有し
優秀なサプライヤーとして表彰獲得



TSMC



Intel



SK hynix

グローバルな生産体制

半導体メーカーの生産拠点との
地理的優位性のある拠点を保有



本資料に記載されている当社の目標、計画、見積もり、予測、予想、ターゲットその他の将来情報については、本資料の作成時点において、当社が入手できる情報をもとに、一定の前提に基づく当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社の経営成績、財政状態その他の結果は、国内外の経済情勢・市場環境、事業活動、他社との競争環境その他様々な要因等により、本資料の内容又は本資料から推測される内容と大きく異なることがあります。

